

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Όνοματεπώνυμο** : Νικόλαος Γεωργουλάς
- Ημερομηνία γεννήσεως** : Νοέμβριος 1952
- Τόπος γεννήσεως** : Νέα Καρυά Επαρχίας Νέστου, Νομού Καβάλας
- Διεύθυνση εργασίας** : Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δ.Π.Θράκης,
Τηλ. (0541) 79551, Fax. (0541) 79545
e – mail: ngeorgou@ee.duth.gr
- Απασχόληση** : Καθηγητής του Δ.Π.Θ.
- Οικογενειακή κατάσταση**: Παντρεμένος, δύο παιδιά 33 ετών

II. ΣΠΟΥΔΕΣ

1. 1978-Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dipl. Ing.) του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, Γερμανίας.
2. 1981-Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dr. Dipl. Ing.) του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου, Γερμανίας.

III. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

A. Διδασκαλία

1. 1984-1985: Διδασκαλία του μαθήματος "Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών II" στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δ.Π.Θράκης.

2. 1985-1986: Διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μεταλλογνωσία" στους φοιτητές του 2ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
3. 1985-1986: Διδασκαλία του μαθήματος "Ειδικά Κεφάλαια Μεταλλογνωσίας" στους φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
4. 1986-σήμερα: Διδασκαλία του μαθήματος "Ηλεκτρονικός Θόρυβος" στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
5. 1986-1989: Διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών" στους φοιτητές του 2 εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης
6. 1986-1992: Διδασκαλία του μαθήματος "Ηλεκτρονική Ι" στους φοιτητές του 5 εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
7. 1989-1990: Διδασκαλία του μαθήματος "Ηλεκτρονική ΙΙΙ" στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
8. 1989-1994: Διδασκαλία του μαθήματος "Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Ίνες" στους φοιτητές του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
9. 1993 - σήμερα: Διδασκαλία του μαθήματος "Κβαντοηλεκτρονική και Ολοκληρωμένα Οπτική" του 9ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
10. 2004 - σήμερα: Διδασκαλία του μαθήματος "Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές" του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
11. 1995 - σήμερα: Διδασκαλία των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων:
 1. Τεχνολογία VLSI και προσομοίωση διεργασιών
 2. Ηλεκτρονικά στοιχεία ημιαγωγών, προτυποποίηση και προσομοίωση
 3. Αισθητήρες Πυριτίου

B. Συμβολή σε Μεταπτυχιακές Σπουδές

1. Επιβλέπων δύο (2) Διδακτορικών Διατριβών που περατώθηκαν στο Τμήμα ΗΜ&ΜΥ.
2. Μέλος έξι (6) Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για την καθοδήγηση Διδακτορικών Διατριβών, που περατώθηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης, και μέλος των αντίστοιχων Εξεταστικών Επιτροπών.
3. Επιβλέπων δύο (2) Διδακτορικών Διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
4. Μέλος τριών (3) Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών για την καθοδήγηση Διδακτορικών Διατριβών, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

IV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

A. Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές θέσεις

1. 1978-1982: Επιστημονικός Συνεργάτης στην Έδρα Τεχνικής Ηλεκτρονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου, Γερμανίας.
2. 1982-1983: Δωδεκάμηνη θητεία στον Ελληνικό Στρατό, ως Γραφέας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
3. 1983-1985: Ωρομίσθιος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι Καβάλας.
4. 1985-1989: Λέκτορας του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
5. 1989-1994:Επίκ. Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
6. 1994-2002:Αναπλ. Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.

7. 2003- σήμερα: Καθηγητής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
8. 1995-1997: Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
9. 1997-2001: Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.
10. 1997-2001: Μέλος της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης.
11. 1997-2001: Μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δ.Π.Θράκης.
12. 1997- 2001 : Μέλος της Συγκλήτου του Δ. Π. Θράκης.
13. 1997 – 2003: Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Δ. Π. Θράκης.
14. 1997- 2003: Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θράκης.
15. 2004- σήμερα: Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών

B. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

1. **Infrarotempfindlichkeit von Bulk-Barrier-Dioden**, ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 28 μηνών σε συνεργασία του τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και του Ερευνητικού Κέντρου της Εταιρίας Siemens (προϋπολογισμός 120.000 €).
2. **Κατασκευή και χαρακτηρισμός νέων άμορφων ημιαγωγικών υλικών**. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θράκης, διάρκειας 12 μηνών (προϋπολογισμός 12.000 €).
3. **Τεχνολογία άμορφων ημιαγωγών και Φ/Β στοιχείων για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας**. Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ΠΕΝΕΔ, διάρκειας 24 μηνών (προϋπολογισμός 12.000 €).
4. **STRIDE HELLAS 8** («Βελτίωση της υποδομής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Βιομηχανίας για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (με την εγκαθίδρυση δεσμών R &D»)). Υπεύθυνος της Φάσης 1 (Προμήθεια και

Εγκατάσταση του E+T Εξοπλισμού) του πιο πάνω Ερευνητικού Προγράμματος, που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. διαμέσου του ΥΒΕΤ, του ΥΠΕΠΘ και Δ.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) (προϋπολογισμός 2.205.000 €, περίπου).

5. **STRIDE HELLAS 187** («Ελληνικό Περιβάλλον Σχεδιασμού και Κατασκευής Πρωτοτύπων Κυκλωμάτων πολύ Υψηλής Κλίμακας Ολοκλήρωσης») που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. διαμέσου του ΥΒΕΤ, του ΥΠΕΠΘ και Δ.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) (προϋπολογισμός 103.000 €, περίπου)
6. **Σχεδιασμός, κατασκευή, μελέτη και βελτιστοποίηση φωτοδιόδου Si με υψηλή κβαντική απόδοση στην μπλε περιοχή του ορατού φάσματος.** Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού προγράμματος που πραγματοποιείται στα πλαίσια του ΠΕΝΕΔ'95, διάρκειας 24 μηνών (προϋπολογισμός 23.500 €).
7. **Ίδρυση, Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.** Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Α ΕΠΕΑΕΚ, διάρκειας τριών ετών (προϋπολογισμός 820.000 €).
8. **Σειρήνες, «Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως Τεχνολογικό Κέντρο Παγκόσμιας Επικοινωνίας και Μάθησης», Α' Φάση: Μελέτη** στα πλαίσια του Α ΕΠΕΑΕΚ. (προϋπολογισμός 30.000 €).
9. **Σειρήνες, «Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως Τεχνολογικό Κέντρο Παγκόσμιας Επικοινωνίας και Μάθησης», Β' Φάση: Παραγωγή Εκπαιδευτικού Λογισμικού** στα πλαίσια του Α' ΕΠΕΑΕΚ (προϋπολογισμός 88.000 €).
10. **Βελτίωση της Υποδομής του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τμήματος ΗΜ & ΜΥ του Δ.Π. Θράκης.** Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου που υλοποιείται με κονδύλια του ΤΣΜΕΔΕ (προϋπολογισμός 40.000 €).
11. **Επέκταση της βελτίωσης της Υποδομής του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τμήματος ΗΜ & ΜΥ του Δ.Π. Θράκης.** Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου που υλοποιείται με κονδύλια του ΤΣΜΕΔΕ (προϋπολογισμός 18.000 €).
12. **Ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δ.Π. Θράκης** στα πλαίσια του Α ΕΠΕΑΕΚ (προϋπολογισμός 294.000 €)
13. **Ανάπτυξη Προηγμένων Εύκαμπτων Κλωστοϋφαντουργικών και άλλων Υλικών με Φωτοβολταϊκά Στοιχεία.** Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου που υλοποιείται στα πλαίσια

του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ 2000-2006, Μέτρο 2.1 (Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας) ,συνολικού προϋπολογισμού 999.700,00 € (Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ, ΑΛΟΥΚΟΜ , DON & LOW , ΕΤΑΚΕΙ)

14. **ΘΑΛΗΣ - CYBERSENSORS - Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS) ΚΑΕ - 80193**», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ)
15. **ΘΑΛΗΣ- NitPhoto : “High Efficiency III-Nitride Semiconductors Photovoltaic Devices”ΚΑΕ-3568**” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ)
16. **ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-“Next Generation of Low Cost Thin Film Silicon Solar Panels with Improved High Energy Yield”**, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ)
17. **ESA, “High Specific Energy Lithium Cells for Space Exploration”**, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (**ESA, European Space Agency**)

Γ. Εκπαιδευτικές άδειες και Επισκέψεις σε Παν/μια του Εξωτερικού

1. Σεπτέμβριος 1988-Φεβρουάριος 1989: Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου, Έδρα Τεχνικής Ηλεκτρονικής, Γερμανία (Εκπαιδευτική Άδεια).
2. Οκτώβριος 1992: Ερευνητική συνεργασία με Ερευνητές της Έδρας Τεχνικής Ηλεκτρονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος "ΠΕΝΕΔ" (Επίσκεψη).
3. Οκτώβριος 2007: Ερευνητική συνεργασία με Ερευνητές της Έδρας Τεχνικής Ηλεκτρονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου στα πλαίσια Ερευνητικού Προγράμματος

Δ. Οργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων

1. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του V Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, που έγινε στην Ξάνθη, Σεπτέμβριος 1989.

2. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του "Τετάρτου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας", που έγινε στην Ξάνθη, Οκτώβριος 1992.
3. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του XI Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, που έγινε στην Ξάνθη, Σεπτέμβριος 1995.
4. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του XVII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, που έγινε στην Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2001.

V. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

1. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (Τ.Ε.Ε.)
2. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής στην Επιστημονική Σειρά ΙΙΙ των εκδόσεων του Τ.Ε.Ε. (Θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής).
3. Μέλος του Ι.Η.Τ (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου).
4. Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Επιστήμης και Τεχνικής της Συμπυκνωμένης Ύλης (Μ.Ε.Ε.Ε.Τ.Σ.Υ.)
5. Μέλος της Επιστημονικής Εταιρείας Micro & Nano

VI. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A. Διδακτορική Διατριβή

1. "Infrarotempfindlichkeit von Bulk-Barrier-Dioden",Dissertation bei der Technischen Universitat Munchen, Δεκέμβριος 1981

B. Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με Κριτές

1. N.Georgoulas, 1982, "The Camel Diode as Photodetector with High Internal Gain", IEEE Electron Dev. Lett. , Vol. EDL-3, No. 3, pp. 61-63.
2. N.Georgoulas, 1985, "Influence of Lattice Defects Produced by Ion Implantation on Electrical and Optical Properties of BulkBarrier-Diodes", Proc. of the NASI on Erosion and Growth of Solids Stimulated by Ion Beams, Crete, Greece, p.435.
3. N.Georgoulas, 1987, "Infra-red sensitivity of bulk-barrier diodes due to lattice defects", IEE Proceedings, Vol. 134, Pt.I, No. 5, pp. 153-155.
4. D.Girginoudi, N.Georgoulas, A.Thanailakis, A.Zdetsis, G.Kiriakidis and A.Christou, April 1988,"Electronic Properties of Sputtered a-Si_{1-x}:Sn_x:H Alloys and Comparison with Electronic Structure Calculations", MRS Symp. Proc., Vol. 118, Reno, Nevada, U.S.A., p. 703.
5. D.Girginoudi, N.Georgoulas, and A.Thanailakis, 1989, "Optical and electronic properties of sputtered hydrogenated amorphous silicon-tin alloys", J. of Appl. Physics, Vol. 66(1), pp. 354-357.
6. N.Georgoulas, 1989, "Optische Barrierenmodulation bei Silizium-Bulk-Barrier-Photodioden", *AEÜ* Band 43, Heft 6, pp. 381-387.
7. A.Mittas, N.Georgoulas, D.Girginoudi, and A.Thanailakis, 1989, "Properties of Amorphous Non-Hydrogenated Silicon-Tin Alloys", Phys. Stat. Sol. (a), Vol. 116, pp. 725-728.
8. L.Magafas, D.Girginoudi, N.Georgoulas and A.Thanailakis, April 1990, "The Influence of Deposition Conditions on the Properties a-SiC:H Thin Films", MRS Symp. Proc., Vol. 192, San Francisco, California, U.S.A. , p.589.
9. S.Girginoudi, D.Girginoudi, N.Georgoulas and A.Thanailakis, Aug. 1990, "Studies of Amorphous Semiconducting Silicon-Lead Alloy Thin Films", Proc. of the 20th Intern. Conf. on the Physics of Semiconductors, Thessaloniki, Greece, p. 2103.
10. L.Magafas, N.Georgoulas, D.Girginoudi, and A.Thanailakis, 1991, "The Dependence of Electrical and Optical Properties of RF Sputtered Amorphous Silicon-Carbon Alloy Thin Films on Substrate Temperature and Hydrogen Flow Rate", Phys. Stat. Sol. (a), Vol. 126, pp. 143-149.

11. F.Lin, M.K.Hatalis, S.Girginoudi, D.Girginoudi, N.Georgoulas and A.Thanailakis, 1992, "Nucleation and Crystallization of Amorphous Silicon-Aluminum Thin Films", MRS Symp. Proc., Vol. 230, Anaheim, U.S.A., p.195.
12. L. Magafas, N.Georgoulas, D.Girginoudi and A.Thanailakis, 1992, "Structural and optical properties of a-SiC:H thin films", Journal of Non-Crystalline Solids, Vol. 139, pp. 146-150.
13. L. Magafas, N.Georgoulas and A.Thanailakis, 1992, "Electrical properties of a-SiC/c-Si(p) heterojunctions", Semicond. Sci. and Technol., Vol. 7, pp. 1363-1368.
14. E.Dimitriadis, N.Georgoulas and A.Thanailakis, 1992, "New a-SiC, Optically Controlled, Thyristor-Like Switch", Electronics Letters, Vol. 28, No.17, pp. 1622-1624.
15. G.N.Bakalidis, N.A.Georgoulas, N.J.Karafolas and C.J.Georgopoulos, 1993, "Design, construction and experimental verification of a fibre optic sensor based on microbending loss mechanism", Int. Journal of Optoelectronics, Vol. 8, No.2, pp. 187-192.
16. N.Georgoulas, L.Magafas, and A.Thanailakis, 1993, "A Study of a-SiC/c-Si(n) Isotype Heterojunctions", Active and Passive Elec. Comp., Vol. 16, pp. 55-64.
17. J.Kalomiros, A. Papadopoulos, S. Logothetidis, L. Magafas, N. Georgoulas, and A. Thanailakis, 1994, "Optical properties of a-SiC:H thin films grown by rf sputtering", Physical Review B, Vol. 49, No.12, pp. 8191-8197.
18. E.I.Dimitriadis, D.Girginoudi, A.Thanailakis and N.Georgoulas, 1995, "New a-Si/c-Si and a-SiC/c-Si based optically controlled switching devices", Semicond. Sci. and Technol., Vol. 10, pp. 523-528.
19. D.Girginoudi, S.Girginoudi, A.Thanailakis, N.Georgoulas, J.Stoemenos, J.Antonopoulos, 1995, "Stability of structural defects of polycrystalline silicon grown by rapid thermal annealing of amorphous silicon films", Thin Solid Films, Vol.268, No.1-2, pp. 1-4.
20. J.A.Kalomiros, E.C.Paloura, A.Ginoudi, S.Kennou, S.Ladas, Ch.Lioutas, N.Vouroutzis, G.Voutsas, D.Girginoudi, N.Georgoulas, A.Thanailakis, 1995, " Surface modification of a-SiC thin films with ex-situ hydrogenation", Solid State Communications, Vol. 96, No 10, pp. 735-738.
21. D. Girginoudi, N.Georgoulas, A.Thanailakis and A.Christou, ", September 1995, "TaSi₂ Emitters for Silicon Bipolar Power Transistors Formed by Rapid Thermal Processing", Proceedings of the 3rd International Conference on "Rapid

- Thermal Processing, RTP-95", Amsterdam, Netherlands.
22. E.I.Dimitriadis, D.Girginoudi, N.Georgoulas and A.Thanailakis, 1996, "New High Speed a-Si/c-Si and a-SiC/c-Si Based Switches", Active and Passive Elec. Comp., Vol. 19, pp. 59-71.
 23. D.Girginoudi, A.Thanailakis, N. Georgoulas, A.Christou, July 1996, "Two-dimensional clusters in SiGe/Si superlattices and their effect on field effect transistor transport characteristics", presented in the 3rd Internat. Conf. on "Superlattices, Microstructures and Microdevices", Liege, Belgium (published as a special issue in the journal: Superlattices and Microstructures, Vol.23, No.2, pp.407-411).
 24. L.Magafas, N.Georgoulas and A.Thanailakis, 1997, "The influence of metal work function on electrical properties of metal/ α -SiC:H Schottky diodes", Microelectronics Journal, Vol. 28, pp.107-114.
 - 25.E.I.Dimitriadis, N.Georgoulas and A.Thanailakis, 1998, "Reversible and irreversible effects on the electrical characteristics of new high- speed α -Si and α -SiC switches", Microelectronics Journal, Vol. 29, pp. 5-11.
 - 26.L.Magafas, N.Georgoulas and A.Thanailakis, 1998, "The a-SiC/c-Si(n) isotype heterojunction as a high sensitivity temperature sensor", Active and Passive Elec. Comp., Vol. 20, pp. 225-234.
 - 27.S.Girginoudi, D.Girginoudi, N.Georgoulas, A.Thanailakis, 1998, "Deposition and crystallization of a-Si thin films by rapid thermal processing", Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 1, pp. 287-292.
 - 28.S.Girginoudi, D.Girginoudi, A.Thanailakis, N.Georgoulas, and V. Papaioannou, 1998, "Electrical and structural properties of poly-Si films grown by furnace and rapid thermal annealing of amorphous Si", J. of Appl.Phys. , Vol. 84, No.4, pp. 1968-1972.
 - 29.I.Karafyllidis, N.Georgoulas, P.I Hagouel and A.Thanailakis, 1998, "Simulation of deposition- Topography granular distortion for TCAD", Modelling Simul. Mater.Sci.Eng., Vol 6, pp. 199-210.
 - 30.D. Girginoudi, A. Thanailakis, N. Georgoulas, V. Kasabyan, A. Christou, 1998, "Two-dimensional clusters in SiGe/Si heterostructures and their effect on field effect transistor transport characteristics", Superlattices and Microstructures, Vol. 23, No. 2, pp. 407-411.

31. S. Girginoudi, D. Girginoudi, N. Georgoulas, A. Thanailakis, June 1998, "Deposition and crystallization of a-Si thin films by rapid thermal processing", presented in the MRS 1998 Spring Meeting, Strasbourg, France (published as a special issue in the journal: Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 1, pp. 287-292.).
32. G. Ch. Sirakoulis, I. Karafyllidis, D. Soudris, N. Georgoulas, and A. Thanailakis, 1998, "An Oxidation Process Simulator for TCAD", Proceedings of the 20th International Spring Seminar on Semiconductor and Hybrid Technologies, Sofia, Bulgaria, p. 103.
33. G. Ch. Sirakoulis, I. Karafyllidis, D. Soudris, N. Georgoulas and A. Thanailakis, 1999, "A new simulator for the oxidation process in integrated circuit fabrication based on cellular automata", Modelling and Simul. Mater. Sci. Eng., Vol. 7, pp. 631-640.
34. N. Georgoulas, D. Girginoudi, A. Mitsinakis, M. Kotsani and A. Thanailakis, November 2000, "Rapid thermal annealing of arsenic implanted silicon for the formation of ultra shallow n⁺p junctions", Proc. of First Intern. Conf. on Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology, Athens, Greece, p. 119.
35. P. Papadopoulou, N. Georgoulas, L. Georgopoulos, A. Thanailakis, 2001, "A model for the dc electrical behavior of bulk-barrier diodes", Electrical Engineering, Archiv für Elektrotechnik, Vol. 83 (4), pp. 203-211.
36. I. Karafyllidis, M. G. Danikas, N. Georgoulas, A. Thanailakis, 2001, "A Model for Dielectric Breakdown in Integrated Circuits Using Cellular Automata", Journal of Electrical Engineering, Vol. 53 (7-8), pp. 208-213.
37. P. Papadopoulou, N. Georgoulas, A. Thanailakis, 2002, "Simulation and experimental results on the switching behavior of bulk-barrier diodes", Microelectronics Journal, Vol. 33 (5-6), pp. 487-494.
38. L. Magafas, N. Georgoulas, A. Thanailakis, 2002, "Optical response of the Al/a-SiC/c-Si(p)/Au heterojunction structure", Microelectronics Journal, Vol. 33(9), pp. 761-764.
39. P. Papadopoulou, N. Georgoulas, A. Thanailakis, 2002, "An extensive study of the photocurrent amplification mechanism of silicon bulk - barrier diodes based on simulation and experimental results", Thin Solid Films, Vol. 415, pp. 276-284.
40. Girginoudi, N. Georgoulas, A. Thanailakis E.K. Polychoniadis, "Studies of ultrashallow n⁺-p junction formed by low-energy As-implantation" Materials Science and Engineering B,

- Vol. 114-115, (2004) pp. 381-385
- 41.D. Girginoudi, A. Mitsinakis, N. Georgoulas, A. Thanailakis, M. Kotsani, A.G. Kontos, V.C. Stergiou and Y.S. Raptis, 2004 , “Properties of polycrystalline silicon film obtained by rapid thermal processing for micromechanical sensors” Journal of Non-Crystalline Solids 343, pp. 54-60.
- 42..A. Hatzopoulos, N. Archontas, N. A. Hastas, C. A. Dimitriadis, G. Kamarinos, N. Georgoulas, and A. Thanailakis, 2004, “ Change in Transfer and Low Frequency Noise Characteristics of n-Channel Polysilicon Thin- Film Transistors Due to Hot-Carrier Degradation”, IEEE Electron Dev. Lett. 25, pp.390
- 43.N. A. Hastas, N. Archontas, C. A. Dimitriadis, G. Kamarinos, T. Nikolaidis, N. Georgoulas, and A. Thanailakis”, 2005, “Substrate Current and Degradation of n-channel Polycrystalline Silicon Thin-Film Transistors “Solid State Electronics” Vol. 45(2) pp.341-348.
44. D. Girginoudi, N. Georgoulas and A. Thanailakis, “Structural and Electrical Characterization of Defects into p⁺n Junctions Formed by Ge-preamorphised Silicon”, E-MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting, Nice, France - May 29 – June 2, 2006
45. N. Archontas, N. Georgoulas, C. A. Dimitriadis, F. Templier, M. Oudwan and G. Kamarinos, 2008, “Two dimensional simulation and modeling of the electrical Behaviour in nanocrystalline silicon thin-film transistors”, J. Appl. Phys. **103**, 104507
46. N. Archontas, N. Georgoulas, D. Girginoudi, A. Thanailakis. And C. A. Dimitriadis, 2008 "Two-dimensional simulations for interface roughness modelling in polysilicon thin- film transistors", Journal of Solid State Electronics, conditionally accepted,
47. D.Girginoudi, C. Tsiarapas and N. Georgoulas, “*Properties of a-Si:H films deposited by RF magnetron sputtering at 95 °C*”, presented in the Spring Meetin , 2009, Symposium B, Strassbourg, France
- 48.. D. Girginoudi, C. Tsiarapas and N. Georgoulas, “*Development of solar cells from RF- sputtered a-SiH films on flexible plastic substrates*”, presented in the 2nd International Symposium On Flexible Organic Electronics (IS-FOE09) 8-10 July, 2009, Halkidiki, Greece

49. D. Girginoudi, C. Tsiarapas and N. Georgoulas , 2011, “ *Properties of a-Si:H films deposited by RF magnetron sputtering at 95 °C*”, Applied Surface Science, 257(9), pp. 3898-3903
50. E. Koutsoumpi, K. Raftopoulou, E. Katsia, C. Sarigiannidis, T. Carlo, C.M. Schmidt, D. Zimin, B. Bondu, F. Farmakis, D. Girgkinoudi and N. Georgoulas, “*Optimization of the ZnO back contact layer in terms of module power increase and cost reduction in 60MW micromorph TM production line*”, to be presented in the 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC), 5-9 September, 2011, Hamburg, Germany.
51. Karafyllidis, I.G. , Georgoulas, N., 2012, ”*Simulation of dye-sensitized solar cells based on a population dynamics model*”, Current Nanoscience, Volume 8, Issue 2, pp. 312-316
52. F.Farmakis, N.Georgoulas, E.Farsari, A.Kalampounias, E.Amanatides, D.Mataras, “*Post oxidation effects of high rate microcrystalline silicon grown by PECVD for solar cell applications*”, PVSEC 2012, 24-28 September 2012.
53. G.Oslovitis, F.Farmakis, N.Georgoulas, “*Investigation of the impact of front glass properties to the electrical performance of a-Si/uc-Si tandem cells by numerical simulation*”, PVSEC 2012, 24-28 September 2012.
54. Filippou Farmakis, Kostas Alexandrou, Costas Elmasides, Ioannis Kymissis and Nikolaos Georgoulas, “*Amorphous silicon – graphene anodes for lithium ion batteries*”, SPIE Micro-Technologies, Grenoble 24 - 26 April ,2013.
55. C. Tsiarapas, D. Girginoudi and N. Georgoulas, 2013, "*Electrical Characteristics of Pd Schottky Contacts On ZnO Films*", accepted for publication in Materials Science in Semiconductor Processing

Δ. Εργασίες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές

1. Λ.Μαγκαφάς, Ν.Γεωργουλάς, Δ.Γκιργκινούδη και Α.Θαναηλάκης, Νοέμβριος 1988, "Μελέτη Ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων a-SiC:H για Φωτοβολταϊκές Μετατροπείς", Πρακτικά 3 Εθνικού Συνεδρίου , "ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", Θεσσαλονίκη, Τόμος Α', σελ. Η.Ε.Φ.11.
2. Α. Μήττας, Ν.Γεωργουλάς, Δ.Γκιργκινούδη και Α.Θαναηλάκης, Νοέμβριος 1988, "Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός λεπτών Υμενίων a-Si/Sn ως Υλικά", Πρακτικά Τρίτου Εθνικού συνεδρίου , "ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", Θεσ/νίκη, Τόμος Α, σελ. Η.Ε.Φ-21.

3. Λ. Μαγκαφάς, Ν.Γεωργουλάς, Δ.Γκιργκινούδη και Α.Θαναηλάκης, Σεπτέμβριος 1988, "Λεπτά Υμένια a-SiC:H που αναπτύχθηκαν με τη μέθοδο RF Sputtering", Πρακτικά IV Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Αθήνα σελ. 269.
4. Α. Μήττας, Ν.Γεωργουλάς, Δ.Γκιργκινούδη και Α.Θαναηλάκης, Σεπτ. 1988, "Ιδιότητες λεπτών Υμενίων Κραμάτων a-Si/Sn", Πρακτικά IV Πανελληνίου συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Αθήνα, σελ. 236.
5. Λ. Μαγκαφάς, Ν.Γεωργουλάς, Δ.Γκιργκινούδη και Α.Θαναηλάκης, Σεπτ. 1989, "Επίδραση των συνθηκών ανάπτυξης πάνω στις ιδιότητες λεπτών υμενίων a-SiC:H", Πρακτικά V Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη, σελ. 167-172.
6. Ν. Γεωργουλάς και Α.Θαναηλάκης, Σεπτ. 1989, "Μπλε Ευαισθησία των διόδων Bulk-Barrier", Πρακτικά V Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη, σελ. 161-166.
7. Λ. Μαγκαφάς, Ν. Γεωργουλάς και Α. Θαναηλάκης Σεπτ. 1991, "Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων των Ετεροεπαφών του τύπου a-SiC/c-Si", Πρακτικά VII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Θεσ/νίκη, σελ. 316-321.
8. Δ. Γκιργκινούδη, Ν.Γεωργουλάς και Α. Θαναηλάκης, Σεπτ. 1991, "Φωτοδιόδοι τύπου Pd-SiO₂-Si με Υψηλή Ευαισθησία στην ορατή περιοχή", Πρακτικά VII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής στερεάς Κατάστασης Θεσ/νίκη, σελ. 155-160.
9. Λ. Μαγκαφάς, Ν.Γεωργουλάς και Α.Θαναηλάκης, Οκτ.1992, "Ετεροεπαφές τύπου a-SiC/c-Si ως Φωτοβολταϊκά Στοιχεία", Πρακτικά Τέταρτου Εθνικού Συνεδρίου, "ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", Ξάνθη, Τόμος Β, σελ Η.Ε.Φ. 62.
10. Δ.Γκιργκινούδη, Ν.Γεωργουλάς, Σ.Γκιργκινούδη και Α.Θαναηλάκης, Οκτ. 1992, "Δίοδοι Schottky από Λεπτά Υμένια Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου ως Φωτοβολταϊκά Στοιχεία", Πρακτικά Τέταρτου Εθνικού Συνεδρίου, "ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ", Ξάνθη, Τόμος Β, σελ. Η.Ε.Φ- 54.
11. Δημητριάδης, Ν.Γεωργουλάς και Α.Θαναηλάκης, Σεπτ. 1992, "Θυρίστορ του τύπου Al/a-SiC/c-Si(p)/c-Si(n)/Al, Πρακτικά VIII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ιωάννινα, σελ. 224-228.
12. Σ.Μπουλατάκης, Σ.Λογοθετίδης, Α.Παπαδόπουλος, Σ.Βές, Δ.Γκιργκινούδη, Ν.Γεωργουλάς και Α.Θαναηλάκης, Σεπτέμβριος 1993, "Χαρακτηρισμός Λεπτών Υμενίων SiO₂/Si με

- φασματοσκοπική Ελλειψομετρία και Φασματοσκοπία Raman" Πρακτικά ΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Πάτρα, σελ. : 351-355.
11. Ε.Ι.Δημητριάδης, Δ.Γκιργκινούδη, Α. Θαναηλάκης και Ν.Γεωργουλός, Σεπτέμβριος 1994, "Εμφύτευση Ιόντων Ρ και Β σε λεπτά Υμένια Άμορφου Πυριτίου. Πρακτικά Χ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Δελφοί (Αθήνα), 18-21 Σεπτεμβρίου 1994, σελ.: 354-358.
 12. Σ. Γκιργκινούδη, Δ.Γκιργκινούδη, Ν.Γεωργουλός, Α.Θαναηλάκης, Ι.Στοιϊμένος και Ι.Αντωνόπουλος, Σεπτέμβριος 1994, "Σταθερότητα Δομικών Ατελειών Πολυκρυσταλλικού Si που Αναπτύσσεται με την Τεχνική LPCVD. Πρακτικά Χ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Δελφοί (Αθήνα), 18-21 Σεπτεμβρίου 1994, σελ.: 63-66.
 13. Ι. Καλόμοιρος, Ε.Παλούρα, Α.Γκιρνούδη, Σ.Κέννου, Σ.Λαδάς, Α.Αναγνωστόπουλος, Ι.Σπυριδέλης, Δ.Γκιργκινούδη, Λ.Μαγκαφάς, Ν.Γεωργουλός και Α.Θαναηλάκης, Σεπτέμβριος 1994, "Ex-situ Υδρογόνωση Λεπτών Υμενίων Αμόρφου Ανθρακοπυριτίου Αναπτυγμένων με rf-sputtering", Πρακτικά Χ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Δελφοί (Αθήνα), 18-21 Σεπτεμβρίου 1994, σελ.: 211-214.
 14. Δ. Γκιργκινούδη, Λ.Κυλιντηρέας, Λ.Μαγκαφάς, Σ.Γκιργκινούδη, Λ.Γεωργόπουλος, Ε.Δημητριάδης, Ν.Γεωργουλός και Α.Θαναηλάκης, "Επιφανειακές Τεχνολογικές Διεργασίες CVD και PVD και Εφαρμογές τους στην Ελλάδα".Παρουσιάστηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) στα πλαίσια της ημερίδας με θέμα "Μη συμβατικές διεργασίες Τεχνολογία και Εφαρμογή τους στην Ελλάδα", Αθήνα, Μάρτιος 1995.
 15. Ε. Δημητριάδης, Δ.Γκιργκινούδη, Ν.Γεωργουλός, και Α.Θαναηλάκης Σεπτέμβριος 1995, "Ηλεκτρονικός Διακόπτης Υψηλής Ταχύτητας του Τύπου Al/α-SiC/c-Si(n⁺)/Al. Πρακτικά ΧΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ξάνθη, Σεπτέμβριος 1995, σελ.: 95-100.
 16. Δ. Γκιργκινούδη, Σ.Γκιργκινούδη Ν.Γεωργουλός, και Α.Θαναηλάκης, "Χαρακτηρισμός Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου που Αναπτύσσεται με την Τεχνική της Ταχείας Θερμικής Διεργασίας". Πρακτικά ΧΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ξάνθη, Σεπτέμβριος 1995, σελ.: 83-89.

17. Α. Γεωργόπουλος, Ν.Γεωργουλός, Α.Μαγκαφάς και Α.Θαναηλάκης, “Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιότητων των Διόδων Bulk-Barrier”. Πρακτικά XI Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ξάνθη, Σεπτέμβριος 1995, σελ.: 15-22.
18. Α. Γεωργόπουλος, Ν. Γεωργουλός, Α. Θαναηλάκης, "Η χρήση της Τεχνικής SOD (Spin On Dopands) σε συνδυασμό με την τεχνική RTP (Rapid Thermal Processing) στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Στοιχείων χαμηλού κόστους" Παρουσιάστηκε στο XII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Σεπτέμβριο του 1996.
19. Μαγκαφάς Α., Ν.Γεωργουλός και Α.Θαναηλάκης "Ισότυπη ετεροεπαφή του τύπου α -SiC/c-Si(n) ως αισθητής θερμοκρασιών υψηλής ευαισθησίας Παρουσιάστηκε στο XII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1996.
20. Σ. Γκιργκινούδη, Ν. Γεωργουλός, Δ. Γκιργκινούδη και Α.Θαναηλάκης "Χαρακτηρισμός Λεπτών Υμενίων SiO₂ που αναπτύχθηκαν με την τεχνική της Ταχείας Θερμικής Οξειδωσης Παρουσιάστηκε στο XII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1996.
21. Ε. Δημητριάδης, Δ. Γκιργκινούδη, Ν. Γεωργουλός, και Α.Θαναηλάκης "Διακόπτης Κατωφλίου με χρόνο εναλλαγής της τάξης των ns", Παρουσιάστηκε στο XII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1996.
22. Σ. Γκιργκινούδη, Δ. Γκιργκινούδη, Α. Θαναηλάκης, Ν. Γεωργουλός και Ε. Παπαϊωάννου, 1997, «Ηλεκτρικές και Δομικές Ιδιότητες Υμενίων Πολυκρυσταλλικού Si με εμφυτευμένα ιόντα αρσενικού». Πρακτικά γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Πειραιά Θεσσαλονίκης, 21-24 Σεπτεμβρίου, 1997, σελ. : 65-68.
23. Π. Παπαδοπούλου, Α. Γεωργόπουλος, Ν. Γεωργουλός και Α. Θαναηλάκης, 1997, “Προσομοίωση της Οπτικής και Ηλεκτρικής Συμπεριφοράς της Bulk Barrier Διόδου”. Πρακτικά γ' Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Πειραιά Θεσσαλονίκης, 21-24 Σεπτεμβρίου, 1997, σελ.: 535-538.
24. Π. Παπαδοπούλου, Ν. Γεωργουλός, και Α. Θαναηλάκης, 1998, “Ανάλυση της Μεταβατικής Συμπεριφοράς των Διόδων Bulk-Barrier (BB) με την βοήθεια Προσομοίωσης”, Πρακτικά του XIV Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ιωάννινα, 15-18 Σεπτεμβρίου, 1998, σελ. : 533-537.

25. Λ. Γεωργόπουλος, Ν. Γεωργουλός, Α. Θαναηλάκης, και Δ. Γκιργκινούδη, 1998, “Κατασκευή Ρηχών Επαφών σε c-Si με Ταχεία Θερμική Διάχυση Προσμίξεων As από Πηγές Spin-On”, Πρακτικά του XIV Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ιωάννινα, 15-18 Σεπτεμβρίου, 1998, σελ.: 529-532.
26. Ματζίρης Σ. Π., Γεωργουλός Ν., Γκιργκινούδη Δ. και Θαναηλάκης Α.: “Μελέτη βαθέων παγίδων με τη χρήση της τεχνικής DLTS σε δομές πυριτίου του τύπου p^+np που έχουν υποστεί ταχεία θερμική ανόπτηση”. Πρακτικά XV Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Πάτρα 27- 29 Σεπτεμβρίου 1999, σελ.: 95-98.
27. Μητσινάκης Α., Κοτσάνη Μ., Γκιργκινούδη Δ., Γεωργουλός Ν., Θαναηλάκης Α., Κόντος Α., Στεργίου Β. και Ράπτης Γ. : “Επίδραση των τεχνολογικών παραμέτρων στις ιδιότητες πολυκρυσταλλικού πυριτίου για μικρομηχανικούς αισθητήρες”. Πρακτικά XVII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2001, σελ.: 208-211.
28. Γκιργκινούδη Δ., Αναστασίου Α., Μητσινάκης Α., Γεωργουλός Ν. και Θαναηλάκης Α.: “Εξάρτηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των επαφών n^+p πυριτίου από τις διεργασίες της εμφύτευσης ιόντων As και της ταχύτατης θερμικής ανόπτησης”. Πρακτικά XVII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2001, σελ.: 212-215.
29. Ματζίρης Σ. Π., Γεωργουλός Ν., Γκιργκινούδη Δ. και Θαναηλάκης Α.: “Μελέτη βαθέων παγίδων σε ρηχές επαφές πυριτίου του τύπου p^+n που έχουν υποστεί ταχεία θερμική ανόπτηση”. Πρακτικά XVII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2001, σελ.: 221-224.
30. Παπαδοπούλου Π., Γεωργουλός Ν., Θαναηλάκης Α.: “Επίδραση της Συχνότητας Διαμόρφωσης του Προσπίπτοντος Φωτός πάνω στην Εξωτερική Κβαντική Απόδοση Φωτοδιόδων Πυριτίου του τύπου p^+np ”. Πρακτικά XVII Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ξάνθη 6 - 9 Σεπτεμβρίου 2001, σελ.: 216-220.
31. C. Tsiarapas, D. Girginoudi, N. Georgoulas and V. Stathopoulos, “Properties Of ZAO Films Sputtered With Various Deposition Power And Annealed In Air Or N₂/H₂”, XXIX Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Athens, September 22-25, 2013

VII. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναφορές στις επιστημονικές εργασίες από άλλους ερευνητές περισσότερες από 200.

VIII. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ

1. Ν. Γεωργουλάς, Δ. Γκιργκινούδη, «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών». Πανεπιστημιακές παραδόσεις για το μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών», που διδάσκεται στο 4^ο εξάμηνο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.

2. Ν. Γεωργουλάς, «Κβαντοηλεκτρονική και Ολοκληρωμένη Οπτική». Πανεπιστημιακές παραδόσεις για το μάθημα «Κβαντοηλεκτρονική και Ολοκληρωμένη Οπτική», που διδάσκεται στο 9^ο εξάμηνο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θράκης.